


 行业动态
Industry News

全球40纳米世代NAND Flash大战将起 海力士重金研发57nm制程

2007-12-25 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

2007年在全球NAND型快闪记忆体(Flash)市场竞局大多处于苦苦追赶状况的海力士(Hynix),为能在2008年与东芝(Toshiba)、三星电子(Samsung Electronics)一较高低,于2007年投入大量研发资源在57奈米制程技术,不过,在量产不到1季便将提前下台,海力士48奈米制程已确定在2008年第1季开始量产,这样进度将较2大龙头大厂三星及东芝足足快上半年,足见海力士亟欲在2008年扳回一城的决心及气势。

海力士2007年于NAND Flash制程技术进度,可说完全处于挨打局面,往往竞争对手已转进下一世代量产,海力士却仍仅能采前一代制程技术与竞争对手力拼,当三星及东芝已纷转进50奈米制程世代时,海力士却只能用60奈米制程技术死守既有客户,这对于海力士而言,可说一直处于不利位置,为此海力士于2007年投下重金研发57奈米制程,誓言要藉此抢回部分失去的市占率。

不过,这样进度对于海力士而言,似乎依然无法达到大举抢回市占率目的,原因在于海力士57奈米制程必须等到2007年12月才能正式投入量产,相较于其他竞争对手在50奈米制程量产时间,均已

有一段时间差距,因此,在成本竞争上,海力士恐将持续处于挨打局面,为此海力士痛定思痛,加快48奈米制程技术量产,希望在40奈米世代可较竞争对手快,藉以挽回既有市场颓势。

目前海力士48奈米制程已确定可在2008年第1季进入量产阶段,且初步投产量一举可拉高至约2万片规模,相较于东芝或三星在40奈米制程世代量产时间点,海力士此次确实已扳回一城。半导体业者指出,东芝45奈米制程时间表为2008年第1季才会有样本出来,而依照正常从样本出来到量产所需时间推算,东芝45奈米制程量产时间可能落在2008年第3季左右。

同样地,三星旗下40奈米制程进度与东芝不相上下,半导体业者表示,三星45奈米制程量产时间点也需要等到2008年第3季,2大厂40奈米制程世代进度与海力士相较,足足晚半年左右时间,这对于海力士而言,无疑将是一大利多。

部分NAND Flash业者认为,海力士宣称48奈米制程将于2008年第1季便进入量产,这对于东芝与三星来说,确实将会对2大龙头厂构成重重一击;但亦有业者认为,海力士恐不太可能如此出乎意料地后来居上,毕竟NAND Flash产品在进入50奈米制程世代量产阶段,便花费各NAND Flash业者相当一段时间,海力

[科普首页](#)
[微电子历史](#)
[行业动态](#)
[术语解释](#)
[无微不至](#)
[芯片制程](#)
[科普创意](#)


士怎么可能在这么短时间内超越2大龙头厂，成为第1家进入40奈米制程世代量产的NAND Flash业者，因而对此抱持保留态度。

（来源：DigiTimes）



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号